Tabelle 20.1 Strom-Spannungs-Beziehungen für den n-Kanal-MOSFET

Betriebsbereich $V_{\rm GS}$ $V_{\rm DS}$ $I_{\rm D}$

	GD.	Do	D
Sperrbereich	$< V_{ m TH}$	beliebig	0

Widerstandsbereich > $V_{\rm TH}$ < $V_{\rm GS} - V_{\rm TH}$ $\beta_{\rm n} \left(V_{\rm GS} - V_{\rm TH} - \frac{V_{\rm DS}}{2} \right) V_{\rm DS}$

Sättigungsbereich $> V_{\rm TH} \ge V_{\rm GS} - V_{\rm TH}$ $\frac{\beta_{\rm n}}{2} (V_{\rm GS} - V_{\rm TH})^2$